

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】平成22年2月4日(2010.2.4)

【公開番号】特開2008-244266(P2008-244266A)
 【公開日】平成20年10月9日(2008.10.9)
 【年通号数】公開・登録公報2008-040
 【出願番号】特願2007-84619(P2007-84619)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 41/22 (2006.01)

H 0 1 L 41/08 (2006.01)

H 0 1 L 41/09 (2006.01)

H 0 1 L 41/187 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 41/22 Z

H 0 1 L 41/08 D

H 0 1 L 41/08 U

H 0 1 L 41/08 J

H 0 1 L 41/18 1 0 1 D

H 0 1 L 41/08 L

【手続補正書】

【提出日】平成21年12月10日(2009.12.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

- (a) 基体側の上方に第1電極を形成する工程と、
 (b) 前記第1電極の上方に圧電体層を形成する工程と、
 (c) 前記圧電体層の上方に第2電極を形成する工程と、
 (d) 前記第2電極および前記圧電体層の少なくとも一部をパターンングして、前記第1電極、前記圧電体層、および前記第2電極を有するキャパシタ構造部を形成する工程と、
 (e) 前記(d)工程の後に、前記キャパシタ構造部の少なくとも一部を被覆する保護膜を形成する工程と、
 (f) 前記(e)工程の後に、第1のアニールを行う工程と、
 (g) 前記上部電極と電気的に接続する配線膜を形成する工程と、
 を含む、圧電素子の製造方法。

【請求項2】

請求項1において、

前記工程(e)は、

(e1) 保護膜を成膜する工程と、

(e2) 前記保護膜をパターンングする工程と、

前記工程(e1)と(e2)との間に、

第2のアニールを行う工程をさらに含む、圧電素子の製造方法。

【請求項3】

請求項2において、

前記工程 (b) は、
前記圧電体層の前駆体溶液を前記第 1 電極の上方に塗布する工程と、
前記前駆体溶液の結晶化アニールを行う工程と、
を有し、
前記工程 (f) における第 1 のアニールの温度は、前記結晶化アニールの温度より低い
、圧電素子の製造方法。

【請求項 4】

請求項 2 において、
前記工程 (b) は、
前記圧電体層の前駆体溶液を前記第 1 電極の上方に塗布する工程と、
前記前駆体溶液の結晶化アニールを行う工程と、
を有し、
前記第 2 のアニールの温度は、前記結晶化アニールの温度より低い、圧電素子の製造方
法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】圧電素子の製造方法